PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-326162

(43)Date of publication of application: 22.11.2001

(51)Int.Cl.

H01L 21/027

(21)Application number: 2000-144281

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

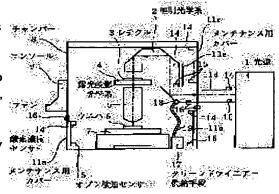
17.05.2000

(72)Inventor: SHIGARAKI TOSHIYUKI

(54) SEMICONDUCTOR MANUFACTURING APPARATUS AND METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor manufacturing apparatus in which the safety of operator is assured and maintenance can be performed rapidly. SOLUTION: In this semiconductor manufacturing apparatus, an inert gas is filled in a chamber 8 as well as 🙀 in a lighting optical system 2 and in a projection aligner optical system 5 and the like for performing exposure processings. A feed means 17 that feeds clean dry air to increase oxygen concentration in a maintenance regions, and sensors 14, 15 that measure oxygen concentration and ozone concentration in maintenance regions, are installed. At maintenance of the apparatus, the clean dry air feed means 17 is operated to increase oxygen concentration in maintenance regions to assure safety of the operator. On maintenance covers 11, switches 12 that detect open status of the covers 11 and lock plungers 13 that lock the maintenance covers 11 when the measured result of at least one of the sensors 14. 15 does not indicate the safety level for human body. are arranged.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection] [Date of extinction of right] (19)日本国特許庁 (JP)

H01L 21/027

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-326162 (P2001-326162A)

(43)公開日 平成13年11月22日(2001.11.22)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01L 21/30

516F 5F046

502G

審査請求 未請求 請求項の数21 OL (全 10 頁)

(21)出願番号 特願2000-144281(P2000-144281)

(22)出願日

平成12年5月17日(2000.5.17)

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 信楽 俊幸

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(74)代理人 100095991

弁理士 阪本 善朗

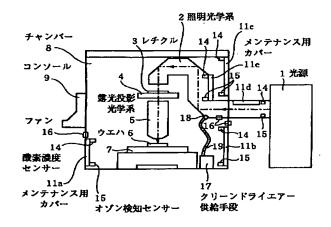
Fターム(参考) 5F046 AA28 DA27 DB03 DB10 DC14

(54) 【発明の名称】 半導体製造装置および半導体デバイス製造方法

(57)【要約】

【課題】 半導体製造装置において、メンテナンス時の作業者の安全を確保し、かつ迅速にメンテナンスを行う ことができる半導体製造装置を提供する。

【解決手段】 チャンバー8内部や照明光学系2 および 露光投影光学系5等に不活性ガスを充填させて露光処理 等を行う半導体製造装置において、メンテナンス領域の 酸素濃度をあげるためのクリーンドライエアーを供給する供給手段17を設けるとともにメンテナンス領域の酸素濃度やオゾン濃度を検出するセンサー14、15を設け、装置のメンテナンス時に、クリーンドライエアー供給手段17を作動させてメンテナンス領域の酸素濃度を上げ、作業者の安全を確保する。また、メンテナンス用カバー11には、その開放状態を検知するスイッチ12と、各センサー14、15の検出結果が人体に安全なレベルになっていない場合にメンテナンス用カバー11をロックするロックプランジャー13を設ける。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 内部空間を外部より酸素濃度を低く設定 する制御手段と、前記内部空間の少なくとも一部の領域 の酸素濃度をあげるために気体を吹き付ける手段とを具 備することを特徴とする半導体製造装置。

【請求項2】 前記酸素濃度をあげるための気体はクリ ーンドライエアーであることを特徴とする請求項 1 記載 の半導体製造装置。

【請求項3】 前記内部空間の一部の領域は、前記半導 体製造装置のメンテナンスを行うメンテナンス領域であ ることを特徴とする請求項1または2記載の半導体製造 装置。

【請求項4】 前記内部空間の酸素濃度を検出するセン サーが設けられていることを特徴とする請求項1ないし 3のいずれかに1項に記載の半導体製造装置。

【請求項5】 前記センサーは前記メンテナンス領域の 酸素濃度を検出することを特徴とする請求項4記載の半 導体製造装置。

【請求項6】 前記センサーによる検出結果を表示する モニターが設けられていることを特徴とする請求項4ま 20 たは5記載の半導体製造装置。

【請求項7】 前記メンテナンス領域にアクセスする際 に信号を出力する検知手段が設けられていることを特徴 とする請求項3ないし6のいずれか1項に記載の半導体 製造装置。

【請求項8】 前記検知手段は、前記メンテナンス領域 ヘアクセスする時のメンテナンス用カバーを開放する動 作を検知し信号を出力することを特徴とする請求項7記 載の半導体製造装置。

【請求項9】 前記メンテナンス領域にアクセスする際 30 に出力される信号に基づいて、前記酸素濃度をあげるた めに気体を吹き付ける手段を作動させることを特徴とす る請求項7または8記載の半導体製造装置。

【請求項10】 前記メンテナンス領域の酸素濃度が所 定の値より低い場合には、該メンテナンス領域のメンテ ナンス用カバーにロックを掛け、該メンテナンス用カバ ーを開放できないように構成することを特徴とする請求 項1ないし6のいずれか1項に記載の半導体製造装置。

【請求項11】 前記半導体製造装置を操作するコンソ ールから前記気体を吹き付ける手段を制御しうるように 40 構成されていることを特徴とする請求項1ないし10の いずれかに1項に記載の半導体製造装置。

【請求項12】 前記コンソールからのメンテナンスモ ードの設定に基づいて前記メンテナンス領域の酸素濃度 を制御することができるように構成されていることを特 徴とする請求項11記載の半導体製造装置。

【請求項13】 前記内部空間の毒性を有する気体の濃 度を検出する第2のセンサーが設けられていることを特 徴とする請求項1ないし12のいずれかに1項に記載の 半導体製造装置。

【請求項14】 前記毒性を有する気体の濃度が所定の 値以上の場合には、該メンテナンス領域のメンテナンス 用カバーにロックを掛け、該メンテナンス用カバーを開 放できないように構成することを特徴とする請求項13 記載の半導体製造装置。

2

【請求項15】 請求項1ないし14のいずれか1項に 記載の半導体製造装置において、ディスプレイと、ネッ トワークインターフェイスと、ネットワークアクセス用 ソフトウェアを実行するコンピュータとをさらに有し、 半導体製造装置の保守情報をコンピュータネットワーク を介してデータ通信することを可能にした半導体製造装

【請求項16】 前記ネットワークアクセス用ソフトウ ェアは、前記半導体製造装置のベンダーもしくはユーザ ーが提供する保守データベースにアクセスするためのユ ーザーインターフェースを前記ディスプレイ上に提供 し、前記コンピュータネットワークに接続されたインタ ーネットまたは専用線ネットワークを介して該データベ ースから情報を得ることを可能にする請求項15記載の 半導体製造装置。

【請求項17】 請求項1ないし16のいずれか1項に 記載の半導体製造装置を含む各種プロセス用の製造装置 群を半導体製造工場に設置するステップと、前記製造装 置群を用いて複数のプロセスによって半導体デバイスを 製造するステップとを有することを特徴とする半導体デ バイス製造方法。

【請求項18】 前記製造装置群をローカルエリアネッ トワークで接続するステップと、前記ローカルエリアネ ットワークと前記半導体製造工場外の外部ネットワーク であるインターネットまたは専用線ネットワークとの間 で、前記製造装置群の少なくとも 1 台に関する情報をデ ータ通信するステップとをさらに有することを特徴とす る請求項17記載の半導体デバイス製造方法。

【請求項19】 前記データ通信によって、半導体デバ イスの製造者または前記半導体製造装置の供給者が提供 するデータベースに前記外部ネットワークを介してアク セスして前記製造装置の保守情報を得、あるいは前記半 導体製造工場とは別の半導体製造工場との間で前記外部 ネットワークを介してデータ通信して生産管理を行うこ とを特徴とする請求項17または18記載の半導体デバ イス製造方法。

【請求項20】 請求項15または16記載の半導体製 造装置を含む各種プロセス用の製造装置群と、半導体製 造工場内で前記製造装置群を接続するローカルエリアネ ットワークと、該ローカルエリアネットワークから該半 導体製造工場外の外部ネットワークであるインターネッ トまたは専用線ネットワークにアクセス可能にするゲー トウェイを有し、前記製造装置群の少なくとも1台に関 する情報をデータ通信することを可能にしたことを特徴 50 とする半導体製造工場。

【請求項21】 請求項15または16記載の半導体製 造装置の保守方法であって、半導体製造工場に設置され た半導体製造装置のベンダーあるいはユーザーが、半導 体製造工場の外部ネットワークであるインターネットま たは専用線ネットワークに接続された保守データベース を提供するステップと、前記半導体製造工場内から前記 外部ネットワークを介して前記保守データベースへのア クセスを許可するステップと、前記保守データベースに 蓄積された保守情報を前記外部ネットワークを介して半 導体製造工場側に送信するステップとを有することを特 10 徴とする半導体製造装置の保守方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体露光装置等 の半導体製造装置においてメンテナンスを安全にかつ迅 速に行うことができる半導体製造装置および半導体デバ イス製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体露光装置においては、半導体素子 の微細化に伴い加工精度の微細化や微細なパターン作成 20 のために、露光用の光源としてより短波長の光束を発す る光源が使用されるようになり、ArFエキシマレーザ 一光(波長192nm)やKrFのエキシマレーザー光 (波長248nm)等の紫外線光、遠紫外線光が用いら れている。しかし、これらの光源から発せられる光の波 長において、例えば、ArFエキシマレーザー光(波長 192nm)は、酸素の吸収波長(193.28nm、 193.70nm) に重なるようになってきた。そし て、露光エネルギーも2kJ以上と非常に大きい。この ような酸素の吸収波長でかつ高エネルギーの照射を行う と、酸素はオゾンに変化する。高濃度のオゾンは人体に 悪影響を与えることが判明している。また、露光光が空 気中の不純物と触れることによって照明光学系や露光投 影光学系のレンズ表面に酸化物が付着し、光の透過率を 下げる原因になる。そとで、このような現象を防ぐため に、半導体製造装置では、照明光学系や露光投影光学系 の内部に窒素やヘリウム等の不活性ガスを充填させ、あ るいは、光学系にクリーンドライエアーを充填して、露 光光と積極的に反応させてオゾンを発生させることによ り有機物を除去するようにしている。

【0003】この種の半導体製造装置のメンテナンスを 行う場合は、不活性ガスの充満している状態が予想され る領域や、人体に悪影響を与えるオゾン等の毒性を有す るガスの発生が予測される領域等においては、メンテナ ンス用カバーを開けてからメンテナンス領域に十分な酸 素が供給されるのを待ってからメンテナンス作業を行っ ている。そのため、酸素が十分に供給されていない危険 な状態を知らせるためのラベル表示やメンテナンスマニ ュアルによる記載で、作業者に危険性を警告している。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述し たような従来技術においては、メンテナンスに際して、 装置内部に不活性ガスが残留しているか否かの判定が不 確実であって、安全にメンテナンス作業を行うことがで きず、また、作業者がラベル等の指示をうっかり見落と す等の安全確保を怠った場合の安全の保障が不確実であ る。さらに、メンテナンスに際しては、メンテナンス領 域の酸素濃度が充分に上がり、安全が確保できる状態と なってからメンテナンスを行うために、酸素濃度が充分 に上がるのを待つ必要があるためにメンテナンスに時間 がかかるという問題点があった。

【0005】そこで、本発明は、前述した従来技術の有 する未解決の課題に鑑みてなされたものであって、半導 体製造装置におけるメンテナンス時の作業者の安全を確 保し、かつ迅速にメンテナンスを行うことができる半導 体製造装置、および半導体デバイス製造方法を提供する ことを目的とするものである。

[0006]

40

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明の半導体製造装置は、内部空間を外部より酸 素濃度を低く設定する制御手段と、前記内部空間の少な くとも一部の領域の酸素濃度をあげるために気体を吹き 付ける手段とを具備することを特徴とする。

【0007】本発明の半導体製造装置においては、前記 酸素濃度をあげるための気体はクリーンドライエアーで あることが好ましい。

【0008】本発明の半導体製造装置において、前記内 部空間の一部の領域は、前記半導体製造装置のメンテナ ンスを行うメンテナンス領域である。

【0009】本発明の半導体製造装置においては、前記 内部空間の酸素濃度を検出するセンサーが設けられてい ることが好ましく、前記センサーは前記メンテナンス領 域の酸素濃度を検出することが好ましく、さらに、前記 センサーによる検出結果を表示するモニターが設けられ ていることが好ましい。

【0010】本発明の半導体製造装置において、前記メ ンテナンス領域にアクセスする際に信号を出力する検知 手段が設けられていることが好ましく、前記検知手段は 前記メンテナンス領域へアクセスする時のメンテナンス 用カバーを開放する動作を検知し信号を出力することが 好ましい。

【0011】本発明の半導体製造装置において、前記メ ンテナンス領域にアクセスする際に出力される信号に基 づいて、前記酸素濃度をあげるために気体を吹き付ける 手段を作動させることが好ましい。

【0012】本発明の半導体製造装置において、前記メ ンテナンス領域の酸素濃度が所定の値より低い場合に は、該メンテナンス領域のメンテナンス用カバーにロッ クを掛け、該メンテナンス用カバーを開放できないよう 50 に構成することが好ましい。

5

【0013】本発明の半導体製造装置において、前記半 導体製造装置を操作するコンソールから前記気体を吹き 付ける手段を制御しうるように構成されていることが好 ましい。

【0014】本発明の半導体製造装置において、前記コ ンソールからのメンテナンスモードの設定に基づいて前 記メンテナンス領域の酸素濃度を制御することができる ように構成されていることが好ましい。

【0015】本発明の半導体製造装置において、前記内 部空間の毒性を有する気体の濃度を検出する第2のセン 10 サーが設けられていることが好ましく、前記毒性を有す る気体の濃度が所定の値以上の場合には、該メンテナン ス領域のメンテナンス用カバーにロックを掛け、該メン テナンス用カバーを開放できないように構成することが 好ましい。

【0016】本発明の半導体製造装置においては、ディ スプレイと、ネットワークインターフェイスと、ネット ワークアクセス用ソフトウェアを実行するコンピュータ とをさらに有し、半導体製造装置の保守情報をコンピュ ータネットワークを介してデータ通信することを可能に 20 することが好ましく、さらにまた、前記ネットワークア クセス用ソフトウェアは、前記半導体製造装置のベンダ ーもしくはユーザーが提供する保守データベースにアク セスするためのユーザーインターフェースを前記ディス プレイ上に提供し、前記コンピュータネットワークに接 続されたインターネットまたは専用線ネットワークを介 して該データベースから情報を得ることを可能にするこ とが好ましい。

【0017】さらに、本発明の半導体デバイス製造方法 は、前述した半導体製造装置を含む各種プロセス用の製 造装置群を半導体製造工場に設置するステップと、前記 製造装置群を用いて複数のプロセスによって半導体デバ イスを製造するステップとを有することを特徴とする。

【0018】本発明の半導体デバイス製造方法において は、前記製造装置群をローカルエリアネットワークで接 続するステップと、前記ローカルエリアネットワークと 前記半導体製造工場外の外部ネットワークであるインタ ーネットまたは専用線ネットワークとの間で、前記製造 装置群の少なくとも1台に関する情報をデータ通信する ステップとをさらに有することが好ましい。

【0019】本発明の半導体デバイス製造方法において は、前記データ通信によって、半導体デバイスの製造者 または前記半導体製造装置の供給者が提供するデータベ ースに前記外部ネットワークを介してアクセスして前記 製造装置の保守情報を得、あるいは前記半導体製造工場 とは別の半導体製造工場との間で前記外部ネットワーク を介してデータ通信して生産管理を行うことが好まし 61

[0020]

低く設定してあるメンテナンス領域あるいは人体に悪影 響を与えるオゾン等の毒性を有するガスの発生領域に対 して、メンテナンス時に、酸素濃度を上昇させるための 気体を吹き付けることにより、さらに、酸素濃度等を検 出してその検出結果が人体に安全なレベルに達した後に メンテナンスを行うようにすることにより、メンテナン ス領域における作業者の安全を確保することができ、常 に安全にメンテナンス作業を行うことを可能にする。ま た、メンテナンス時に作業時間が短縮でき、メンテナン ス効率を向上させることができる。

[0021]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づ いて説明する。

【0022】図1は、本発明の半導体製造装置の構成を 示す概略図であり、図2は、本発明の半導体製造装置に おけるメンテナンス用カバーの近傍を示す概略図であ

【0023】図1および図2に図示する半導体製造装置 において、 1 は短波長の光を照射する光源であり、 2 は **光源**1から照射される光をレチクル3に導くための照明 光学系である。3は露光パターンが形成されているレチ クルであり、レチクルステージ4に載置されている。レ チクルステージ4はレチクル3を移動させて精度よく位 置決めして固定しあるいはスキャン動作を行うように構 成されている。5は露光投影光学系であり、6は露光対 象のウエハであって、ウエハステージ7に搭載され、ウ エハステージ7はウエハ6を露光位置へ移動させ、ある いはレチクル3に同期してスキャン動作を行うように構 成されている。

【0024】8は装置全体の精密温度調節を行うチャン バーであり、チャンバー8の外側には、半導体製造装置 を操作するためのコンソール9が設置され、とのコンソ ール9は、半導体製造装置でウエハを処理するためのウ エハ情報やレシビ情報、装置の作動状態等を表示する表 示部(モニター)および装置本体に必要なデータや情報 を入力するための入力部を備え、さらに、通常の処理モ ードやメンテナンスモード等の各モードに切り換えてそ れぞれのモードに設定できるように構成される。これに よって、通常の処理操作やメンテナンス作業に際して 40 は、コンソール9において、表示部で各種データを確認 するとともに通常の処理操作やメンテナンスに必要なデ ータや情報を入力部で入力することができる。

【0025】11 (11a、11b……) は、チャンバ -8内の各部材、さらには、照明光学系2等の内部をメ ンテナンスするために各メンテナンス領域にアクセスで きるように複数箇所に開閉可能に配設されたメンテナン ス用カバーである。なお、11a~11cはチャンバー 8に設けられたメンテナンス用カバーを示し、11d、 11eは照明光学系2に設けられたメンテナンス用カバ 【作用】本発明の半導体製造装置によれば、酸素濃度を 50 ーを示す。各メンテナンス用カバー11(11a~11

e) に関連して、メンテナンス用カバー11の開閉によ ってオンオフしてメンテナンス用カバー11の開閉状態 を出力するスイッチ12と、メンテナンス用カバー11 を開放できないようにロックするためのロックプランジ ャー13が設けられ、さらに、各メンテナンス用カバー 11の近傍には、チャンバー8や照明光学系2の内部の 酸素濃度を測定する酸素濃度センサー14およびチャン バー8や照明光学系2の内部のオゾン等の毒性を有する 気体を検出するオゾン検知用センサー15がそれぞれ配 設され、また、チャンバー8や照明光学系2の内部のガ スを排出し外気を取り込むためのファン16が配設され ている。なお、オゾン検知センサー16は、酸素の吸収 波長でかつ高エネルギーを有する露光光の照射により酸 素を反応させて発生するオゾンの高濃度化は人体に悪影 響を与えることが判明しているために、メンテナンス領 域でのオゾンを検知するためのものである。また、チャ ンバー8内にクリーンドライエアーを供給するための供 給手段17が設けられ、クリーンドライエアー供給手段 17は供給路19を介して供給弁18からクリーンドラ イエアーを供給するように構成され、メンテナンス用カ バー11の開放によるスイッチ12のオンに応答して、 あるいは、コンソール9におけるメンテナンスモードの 設定により、クリーンドライエアー供給手段17が駆動 され、供給弁18からクリーンドライエアーを供給し て、メンテナンス領域等における酸素濃度を上昇させ、 メンテナンス作業を安全に行うことができるようにす る。

【0026】以上のように構成される半導体製造装置に おいて、作業者はコンソール9で装置の作動操作を行 う。通常の露光処理に際しては、処理モードの設定によ り、露光シーケンスにより露光処理が開始される。すな わち、図示しない不活性ガス供給手段によりチャンバー 8内や照明光学系2内部に窒素やヘリウム等の不活性ガ スが供給される。これは、半導体露光用の光源1として 用いられるArFやKrFのエキシマレーザー等の光源 から発せられる露光光が空気中の不純物と触れることに よって照明光学系2や露光投影光学系5のレンズ表面に 酸化物が付着し、光の透過率を下げる原因になるため、 これを防ぐべく、チャンバー8内、照明光学系2や露光 投影光学系5の内部に窒素やヘリウム等の不活性ガスを 充填させている。あるいは、照明光学系2や露光投影光 学系5内にクリーンドライエアーを充填して、露光光と 積極的に反応させてオゾンを発生させることにより有機 物を除去することもできる。

【0027】チャンバー8内や照明光学系2等の内部に 不活性ガスが充填されると、光源 1 から短波長の露光光 が照射され、露光光は、照明光学系2を介して整形さ れ、レチクル3上の露光バターンを露光投影光学系5を 介してウエハ6上に結像する。このとき、レチクルステ ージ4とウエハステージ7の間で超精密な位置決めを行 50 において図4に示すフローに沿ってメンテナンスを行う

い、重ね合わせ精度1μm以下を達成する。ウエハ6上 の各露光ショットに一括露光を繰り返し露光パターンの 露光転写を行う。また、スキャニングステッパーにおい ては、前述したステッパー動作に加えて1ショット毎に レチクルステージ4とウエハステージ7が同期してスキ ャニング動作を行う。

【0028】このような通常の露光シーケンスにより露 光処理が行われている場合に、オゾン検知用センサー1 5により一定濃度以上のオゾンが検出されると、露光シ ーケンスを停止し、光源1からの照射も停止する。

【0029】次に、装置のメンテナンスを行う際の手順 について、図3に示すフローに沿って説明する。

【0030】作業者は始めにコンソール9でモードを切 り換えてメンテナンスモードを設定する(ステップS 1)。次いで、作業者は、装置のメンテナンスを行う部 位に行き、図2に示すように、メンテナンス領域にアク セスできるようにメンテナンス用カバー11を開けて、 メンテナンス作業の準備を行う(ステップS2)。この メンテナンス用カバー11の開放によりスイッチ12が オンされ、このスイッチ12の信号に基づいて、クリー ンドライエアー供給手段17が駆動され、供給路19を 介して供給弁18からクリーンドライエアーをメンテナ ンス領域に吹き付ける(ステップS3)。この動作によ り、メンテナンス領域における酸素濃度が上昇し、メン テナンス領域での十分な酸素濃度が確保され、メンテナ ンス作業を安全に行うことを可能にする。なお、メンテ ナンス用カバー11が開放されてスイッチ12がオンに なった状態でも、酸素濃度センサー14やオゾン検知セ ンサー15が未だ人体に安全なレベルでない値を検出し ている場合には(ステップS4~S6)、ファン16を 作動させるとともに、メンテナンス用カバーに対応して 設けられている警告灯を点灯させる(ステップS7)。 ファン16の作動によりメンテナンス領域内のガスを排 出し外気を強制的に吸入して取り込み、メンテナンス領 域内の雰囲気に外気を混合することによって、充分に安 全な酸素濃度またはオゾン濃度の確保を行う。そして、 酸素濃度センサー14やオゾン検知センサー15の検出 結果が人体に安全なレベルに達した後に、警告灯を消灯 させて、作業者にメンテナンス作業を安全に行いうる状 態であることを知らせ(ステップS8)、作業者はメン テナンス作業を開始する (ステップS9)。

【0031】とのように、メンテナンス領域にクリーン ドライエアーを供給し、そして酸素濃度やオゾン濃度を 検出してそれぞれの濃度が人体に安全なレベルに達して いることを確認した後に、メンテナンス作業を開始する ようにすることにより、メンテナンス領域における作業 者の安全を確保することができ、常に安全な作業を行う ことが可能となる。

【0032】また、装置のメンテナンスを行う際の手順

ようにすることもできる。

【0033】作業者は、メンテナンス作業に際して前述 した例と同様に、コンソール9でモードを切り換えてメ ンテナンスモードを設定する(ステップS11)。この メンテナンスモードが設定されると、これに応答して、 クリーンドライエアー供給手段17が駆動され、供給路 19を介して供給弁18からクリーンドライエアーをメ ンテナンス領域に吹き付ける(ステップS12)。そし て、本例においては、メンテナンス用カバー11を開放 する前に、そのメンテナンス領域の酸素濃度およびオゾ 10 ン濃度を酸素濃度センサー14やオゾン検知センサー1 5で確認する (ステップS13)。メンテナンス領域の 酸素濃度およびオゾン濃度が人体に安全なレベルでない ことが酸素濃度センサー14やオゾン検知センサー15 で検知されている場合には(ステップS14、S1 5)、当該メンテナンス用カバー11のロックプランジ ャー13を作動させて、メンテナンス用カバー11に口 ックを掛けて開放できない状態にする。同時に当該メン テナンス用カバー11に対応して警告灯を設けてある場 合には警告灯を点灯させる(ステップS16)。そし て、クリーンドライエアー供給手段17の駆動によるク リーンドライエアーの供給あるいはファン16の作動に よる外気の吸入等により、酸素濃度センサー14やオゾ ン検知センサー15による酸素濃度あるいはオゾン濃度 に関する検出値が人体に安全なレベルになるまで、メン テナンス用カバー11のロック状態を維持する。酸素濃 **度センサー14やオゾン検知センサー15の検出結果が** 人体に安全なレベルに達した際に、メンテナンス用カバ ー11のロック状態を解き、メンテナンス用カバー11 を開放しうるようにするとともに警告灯を消灯する(ス テップS17)。その後に、作業者は、メンテナンス用 カバー11を開放してメンテナンス作業を開始する (ス テップS18、S19)。

【0034】このように本例においては、メンテナンス 領域にクリーンドライエアーを予め供給するとともに、 酸素濃度やオゾン濃度を検出して、酸素濃度やオゾン濃 度が人体に安全なレベルに達していない状態ではメンテ ナンス用カバーをロック状態とし、酸素濃度やオゾン濃 度が人体に安全なレベルに達するまでメンテナンス用カ バーを開放できないように、すなわち、メンテナンス領 40 域にアクセスできないようにすることにより、メンテナ ンス領域における作業者の安全をより一層確保すること ができ、常に安全な作業を行うことが可能となる。

【0035】また、コンソール9のモニターに、各メン テナンス用カバー11に対応する酸素濃度センサー14 やオゾン検知センサー15の検出結果を表示させて、モ ニター上で各センサーの検出結果を確認することができ るようにし、さらに、酸素濃度センサー14やオゾン検 知センサー15の検出結果が人体に安全なレベルになっ ていない場合に警告を出す警告灯をコンソール9に設け 50 1と、各製造装置106の稼働状況を監視する監視装置

ておくこともできる。これにより、メンテナンス作業を 行う予定のメンテナンス領域のメンテナンス用カバー1 1に関して警告がなされていない場合に、すなわち、各 センサー14、15の検出結果が人体に安全なレベルに なっている場合には、作業者は直ちにメンテナンス領域 にアクセスし、メンテナンス作業を行うことができ、ま た、メンテナンス領域のメンテナンス用カバー11に関 して警告がなされている場合には、作業者は、コンソー ル9からクリーンドライエアー供給手段17を遠隔制御 により駆動させてメンテナンス領域にクリーンドライエ アーを供給弁18から供給させてから、その領域のメン テナンス作業に向かうようにする。これにより、作業者 がメンテナンス領域に到達してメンテナンス作業を行う べくメンテナンス用カバー11を開けるときには、メン テナンス領域における酸素濃度やオゾン濃度が充分に安 全なレベルになっていて、メンテナンス作業を素早く行 うことが可能となる。

【0036】次に、前述した半導体製造装置を利用する 半導体デバイスの生産システムについて説明する。本実 施例における半導体デバイス(ICやLSI等の半導体 チップ、液晶パネル、CCD、薄膜磁気ヘッド、マイク ロマシン等)の生産システムは、半導体製造工場に設置 された製造装置のトラブル対応や定期メンテナンス、あ るいはソフトウェアの提供などの保守サービスを製造工 場外のコンピュータネットワークを利用して行うもので

【0037】図5は、全体システムを示す概要図であ り、図中、101は半導体デバイスの製造装置を提供す るベンダー (装置供給メーカー) の事業所である。製造 装置の実例として、半導体製造工場で使用する各種プロ セス用の半導体製造装置、例えば、前工程用機器(露光 装置、レジスト処理装置、熱処理装置、成膜装置等)や 後工程用機器(組立装置、検査装置等)を想定してい る。事業所101内には、製造装置の保守データベース を提供するホスト管理システム108、複数の操作端末 コンピュータ110、これらを結んでイントラネットを 構築するローカルエリアネットワーク(LAN)109 を備える。ホスト管理システム108は、LAN109 を事業所の外部ネットワークであるインターネット10 5に接続するためのゲートウェイと、外部からのアクセ スを制限するセキュリティ機能を備える。

【0038】一方、102~104は、製造装置のユー ザーとしての半導体製造メーカーの製造工場である。製 造工場102~104は、互いに異なるメーカーに属す る工場であっても良いし、同一のメーカーに属する工場 (例えば、前工程用の工場と後工程用の工場等) であっ ても良い。各工場102~104内には、それぞれ、複 数の製造装置106と、それらを結んでイントラネット を構築するローカルエリアネットワーク(LAN)11

としてホスト管理システム107とが設けられている。 各工場102~104に設けられたホスト管理システム 107は、各工場内のLAN111を工場の外部ネット ワークであるインターネット105に接続するためのゲ ートウェイを備える。これにより各工場のLAN111 からインターネット105を介してベンダー101側の ホスト管理システム108にアクセスが可能となり、ホ スト管理システム108のセキュリティ機能によって限 られたユーザーだけがアクセスが許可となっている。具 体的には、インターネット105を介して、各製造装置 10 106の稼動状況を示すステータス情報(例えば、トラ ブルが発生した製造装置の症状)を工場側からベンダー 側に通知する他、その通知に対応する応答情報(例え ば、トラブルに対する対処方法を指示する情報、対処用 のソフトウェアやデータ)や、最新のソフトウェア、へ ルブ情報などの保守情報をベンダー側から受け取ること ができる。各工場102~104とベンダー101との 間のデータ通信および各工場内のLAN111でのデー タ通信には、インターネットで一般的に使用されている 通信プロトコル (TCP/IP) が使用される。なお、 工場外の外部ネットワークとしてインターネットを利用 する代わりに、第三者からのアクセスができずにセキュ リティの高い専用線ネットワーク(ISDN等)を利用 することもできる。また、ホスト管理システムはベンダ ーが提供するものに限らずユーザーがデータベースを構 築して外部ネットワーク上に置き、ユーザーの複数の工 場から該データベースへのアクセスを許可するようにし てもよい。

11

【0039】また、図6は半導体デバイスの生産システ ムの全体システムを図5とは別の角度から切り出して表 現した概要図である。前述した例では、それぞれが製造 装置を備えた複数のユーザー工場と該製造装置のベンダ ーの管理システムとを外部ネットワークで接続して、該 外部ネットワークを介して各工場の生産管理や少なくと も1台の製造装置の情報をデータ通信するものであった が、本例は、複数のベンダーの製造装置を備えた工場と 該複数の製造装置のそれぞれのベンダーの管理システム とを工場外の外部ネットワークで接続して、各製造装置 の保守情報をデータ通信するものである。図中、201 は製造装置ユーザー(半導体デバイス製造メーカー)の 40 製造工場であり、工場の製造ラインには各種プロセスを 行なう製造装置、ここでは例として露光装置202、レ ジスト処理装置203、成膜処理装置204が導入され ている。なお、図6では製造工場201は1つだけ描い ているが、実際は複数の工場が同様にネットワーク化さ れている。工場内の各装置はLAN206で接続されて イントラネットを構成し、ホスト管理システム205で 製造ラインの稼動管理がされている。一方、露光装置メ ーカー210、レジスト処理装置メーカー220、成膜 装置メーカー230などベンダー(装置供給メーカー)

の各事業所には、それぞれ供給した機器の遠隔保守を行うためのホスト管理システム211、221、231を備え、これらは前述したように保守データベースと外部ネットワークのゲートウェイを備える。ユーザーの製造工場内の各装置を管理するホスト管理システム205と各装置のベンダーの管理システム211、221、231とは、外部ネットワーク200であるインターネットもしくは専用線ネットワークによって接続されている。このシステムにおいて、製造ラインの一連の製造機器の中のどれかにトラブルが起きると、製造ラインの稼動が休止してしまうが、トラブルが起きた機器のベンダーからインターネット200を介した遠隔保守を受けることで迅速な対応が可能で、製造ラインの休止を最小限に抑えることができる。

【0040】半導体製造工場に設置された各製造装置 は、それぞれ、ディスプレイとネットワークインターフ ェースと記憶装置にストアされたネットワークアクセス 用ソフトウェアならびに装置動作用のソフトウェアを実 行するコンピュータを備える。記憶装置としては内蔵メ モリやハードディスク、あるいはネットワークファイル サーバーなどである。上記ネットワークアクセス用ソフ トウェアは、専用または汎用のウェブブラウザを含み、 例えば図7に一例を示すような画面のユーザーインター フェースをディスプレイ上に提供する。各工場で製造装 置を管理するオペレータは、画面を参照しながら、製造 装置の機種(401)、シリアルナンバー(402)、 トラブルの発生日や件名(403)、トラブルの緊急度 (405)、症状(406)、対処法(407)、経過 (408)等の情報を画面上の入力項目に入力する。入 力された情報は、インターネットを介して保守データベ ースに送信され、その結果の適切な保守情報が保守デー タベースから返信されディスプレイ上に提示される。ま た、ウェブブラウザが提供するユーザーインターフェー スはさらに図示のごとくハイパーリンク機能(410~ 412)を実現し、オペレータは各項目の更に詳細な情 報にアクセスしたり、ベンダーが提供するソフトウェア ライブラリから製造装置に使用する最新バージョンのソ フトウェアを引き出したり、工場のオペレータの参考に 供する操作ガイド(ヘルプ情報)を引き出したりするこ とができる。

【0041】次に、上記説明した生産システムを利用した半導体デバイスの製造プロセスを説明する。

【0042】図8は半導体デバイスの全体的な製造のフローを示す。ステップS21(回路設計)では半導体デバイスのパターン設計を行う。ステップS22(マスク製作)では設計したパターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップS23(ウエハ製造)ではシリコン等の材料を用いてウエハを製造する。ステップS24(ウエハプロセス)は前工程と呼ばれ、上記用意したマスクとウエハを用いて、リソグラフィ技術によってウエ

13

ハ上に実際の回路を形成する。ステップS25(組立)は後工程と呼ばれ、ステップS24によって作製されたウエハを用いて半導体チップ化する工程であり、アッセンブリ工程(ダイシング、ボンディング)、パッケージング工程(チップ封入)等の組立工程を含む。ステップS26(検査)ではステップS25で作製された半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経て半導体デバイスが完成し、これを出荷(ステップS27)する。前工程と後工程はそれぞれ専用の別の工場で行い、これらの工場毎に上記説明した遠隔保守システムによって保守がなされる。また、前工程工場と後工程工場との間でも、インターネットまたは専用線ネットワークを介して生産管理や装置保守のための情報がデータ通信される。

【0043】図9は、上記ウエハプロセスの詳細なフロ ーを示す。ステップS31(酸化)ではウエハの表面を 酸化させる。ステップS32(CVD)ではウエハ表面 に絶縁膜を成膜する。ステップS33 (電極形成)では ウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップS3 4 (イオン打込み)ではウエハにイオンを打ち込む。ス 20 テップS35 (レジスト処理)ではウエハに感光剤を塗 布する。ステップS36(露光)では露光装置によって マスクの回路パターンをウエハに焼付露光する。ステッ プS37 (現像) では露光したウエハを現像する。 ステ ップS38(エッチング)では現像したレジスト像以外 の部分を削り取る。ステップS39 (レジスト剥離)で はエッチングが済んで不要となったレジストを取り除 く。とれらのステップを繰り返し行うことによって、ウ エハ上に多重に回路バターンを形成する。各工程で使用 する製造機器は上記説明した遠隔保守システムによって 30 保守がなされているので、トラブルを未然に防ぐととも に、もしトラブルが発生しても迅速な復旧が可能で、従 来に比べて半導体デバイスの生産性を向上させることが できる。

[0044]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、酸素濃度を低く設定してあるメンテナンス領域あるいは人体に悪影響を与えるオゾン等の毒性を有するガスの発生領域に対して、メンテナンス時に、酸素濃度を上昇させるための気体を吹き付けることにより、さらに、酸素 40 濃度等を検出してその検出結果が人体に安全なレベルに達した後にメンテナンスを行うようにすることにより、

14

メンテナンス領域における作業者の安全を確保することができ、常に安全にメンテナンス作業を行うことを可能にする。また、メンテナンス時に作業時間が短縮できるため、メンテナンス効率を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の半導体製造装置の構成を示す概略図である。

【図2】本発明の半導体製造装置におけるメンテナンス 用カバーの近傍を示す概略図である。

【図3】本発明の半導体製造装置におけるメンテナンス を行う際の手順の一例を示すフロー図である。

【図4】本発明の半導体製造装置におけるメンテナンス を行う際の手順の他の例を示すフロー図である。

[図5] 半導体デバイスの生産システムの全体概要図である。

【図6】半導体デバイスの生産システムの他の形態を示す全体概要図である。

【図7】トラブルデータベースの入力画面のユーザーインターフェースの一例を示す図である。

0 【図8】半導体デバイスの製造プロセスを示すフローチャートである。

【図9】ウエハブロセスを示すフローチャートである。 【符号の説明】

- 1 光源
- 2 照明光学系
- 3 レチクル
- 4 レチクルステージ
- 5 露光投影光学系
- 6 ウエハ
- 0 7 ウエハステージ
 - 8 チャンバー
 - 9 コンソール
 - 11 メンテナンス用カバー
 - 12 スイッチ
 - 13 ロックプランジャー
 - 14 酸素濃度センサー
 - 15 オゾン検知センサー
 - 16 ファン
 - 17 クリーンドライエアー供給手段
 - 18 供給弁
 - 19 供給路

